

# SN74HCS4075-Q1 車載用、シュミットトリガ入力を搭載したトリプル3入力 OR ゲート

## 1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
  - デバイス温度グレード 1: -40°C ~ +125°C, T<sub>A</sub>
  - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
  - デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 広い動作電圧範囲: 2V ~ 6V
- シュミットトリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
- 低消費電力
  - I<sub>CC</sub>: 100nA (標準値)
  - 入力リーク電流: ±100nA (標準値)
- 5V で ±7.8mA の出力駆動能力

## 2 アプリケーション

- 少ない入力によりエラー信号を監視
- アクティブ Low のイネーブル信号の結合

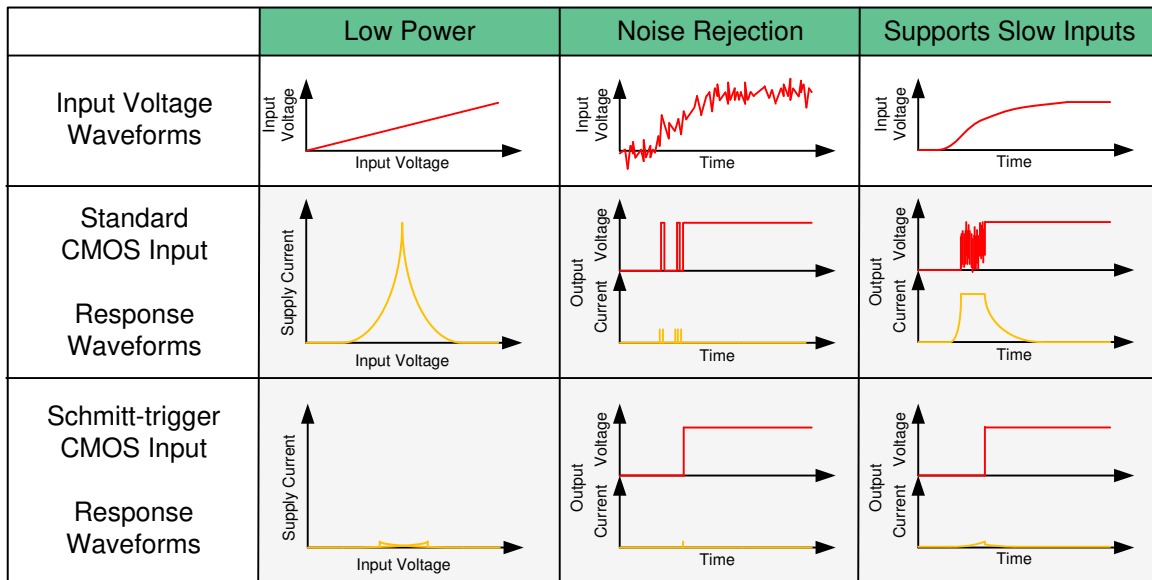
## 3 説明

このデバイスには、3 つの独立した 3 入力 OR ゲートと、シュミットトリガ入力が内蔵されています。各ゲートはブール関数  $Y = A + B + C$  を正論理で実行します。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ(2)
SN74HCS4075QDRQ1	SOIC (14)	8.70mm × 3.90mm
SN74HCS4075QPWRQ1	TSSOP (14)	5.00mm × 4.40mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



シュミットトリガ入力の利点



## 目次

<b>1 特長</b> .....	1	7.3 機能説明.....	8
<b>2 アプリケーション</b> .....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	9
<b>3 説明</b> .....	1	<b>8 アプリケーションと実装</b> .....	10
<b>4 ピン構成および機能</b> .....	3	8.1 使用上の注意.....	10
<b>5 仕様</b> .....	4	8.2 代表的なアプリケーション.....	10
5.1 絶対最大定格.....	4	8.3 レイアウト.....	12
5.2 ESD 定格.....	4	<b>9 デバイスおよびドキュメントのサポート</b> .....	14
5.3 推奨動作条件.....	4	9.1 ドキュメントのサポート.....	14
5.4 熱に関する情報.....	4	9.2 関連リンク.....	14
5.5 電気的特性.....	5	9.3 サポート・リソース.....	14
5.6 スイッチング特性.....	5	9.4 商標.....	14
5.7 代表的特性.....	6	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	14
<b>6 パラメータ測定情報</b> .....	7	9.6 用語集.....	14
<b>7 詳細説明</b> .....	8	<b>10 改訂履歴</b> .....	14
7.1 概要.....	8	<b>11 メカニカル、パッケージ、および注文情報</b> .....	15
7.2 機能ブロック図.....	8		

## 4 ピン構成および機能

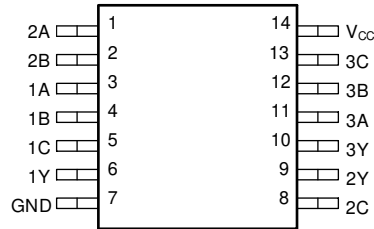


図 4-1. D または PW パッケージ SOIC または 14 ピン TSSOP (上面図)

ピン		タイプ	説明
名称	番号		
1A	3	入力	チャンネル 1、入力 A
1B	4	入力	チャンネル 1、入力 B
1C	5	入力	チャンネル 1、入力 C
1Y	6	出力	チャンネル 1、出力 Y
2A	1	入力	チャンネル 2、入力 A
2B	2	入力	チャンネル 2、入力 B
2C	8	入力	チャンネル 2、入力 C
2Y	9	出力	チャンネル 2、出力 Y
3A	11	入力	チャンネル 3、入力 A
3B	12	入力	チャンネル 3、入力 B
3C	13	入力	チャンネル 3、入力 C
3Y	10	出力	チャンネル 3、出力 Y
GND	7	—	グラウンド
V <sub>CC</sub>	14	—	正の電源

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

削除しました<sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧	-0.5	7	V
I <sub>IK</sub>	入力クランプ電流 <sup>(2)</sup>	V <sub>I</sub> < -0.5 または V <sub>I</sub> > V <sub>CC</sub> + 0.5	±20	mA
I <sub>OK</sub>	出力クランプ電流 <sup>(2)</sup>	V <sub>O</sub> < -0.5 または V <sub>O</sub> > V <sub>CC</sub> + 0.5	±20	mA
I <sub>O</sub>	連続出力電流	V <sub>O</sub> = 0 ~ V <sub>CC</sub>	±35	mA
	V <sub>CC</sub> または GND を通過する連続電流		±70	mA
T <sub>J</sub>	接合部温度 <sup>(3)</sup>		150	°C
T <sub>stg</sub>	保存温度	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、また「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件においても、本デバイスが動作することを暗黙に示すものではありません。「推奨動作条件」の範囲外でも、「絶対最大定格」の範囲内であれば、一時的な動作によってデバイスが損傷するとは限りませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。絶対最大電源電圧定格を超過してはなりません。
- (3) 設計により検証済み。

### 5.2 ESD 定格

		値	単位
V <sub>(ESD)</sub>	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 <sup>(1)</sup> HBM ESD 分類レベル 2 準拠	±4000
		荷電デバイス モデル (CDM)、AEC Q100-011 CDM ESD 分類レベル C6 準拠	±1500

- (1) AEC Q100-002 には、HBM ストレス試験は ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 仕様に従って実施することと規定されています。

### 5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧	2		6	V
V <sub>I</sub>	入力電圧	0		V <sub>CC</sub>	V
V <sub>O</sub>	出力電圧	0		V <sub>CC</sub>	V
Δt/Δv	入力遷移の立ち上がりおよび立ち下がりレート			制限なし	ns/V
T <sub>A</sub>	周囲温度	-40		125	°C

### 5.4 熱に関する情報

熱評価基準 <sup>(1)</sup>		SN74HCS4075-Q1		単位
		PW (TSSOP)	D (SOIC)	
		14 ピン	14 ピン	
R <sub>θJA</sub>	接合部から周囲への熱抵抗	151.7	133.6	°C/W
R <sub>θJC(top)</sub>	接合部からケース (上面) への熱抵抗	79.4	89.0	°C/W
R <sub>θJB</sub>	接合部から基板への熱抵抗	94.7	89.5	°C/W
Ψ <sub>JT</sub>	接合部から上面への特性パラメータ	25.2	45.5	°C/W
Ψ <sub>JB</sub>	接合部から基板への特性パラメータ	94.1	89.1	°C/W

熱評価基準 <sup>(1)</sup>		SN74HCS4075-Q1		単位
		PW (TSSOP)	D (SOIC)	
		14 ピン	14 ピン	
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

## 5.5 電気的特性

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$  で測定した代表値定格 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件		$V_{CC}$	最小値	標準値	最大値	単位
$V_{T+}$	正のスイッチング スレッショルド			2V	1.18		1.3	V
				4.5V	2.39		2.58	
				6V	3.11		3.32	
$V_{T-}$	負のスイッチング スレッショルド			2V	0.61		0.66	V
				4.5V	1.31		1.42	
				6V	1.72		1.87	
$\Delta V_T$	$V_{T+} - V_{T-}$			2V	0.55		0.67	V
				4.5V	1.04		1.21	
				6V	1.34		1.49	
$V_{OH}$	High レベル出力電圧	$V_I = V_{IH}$ または $V_{IL}$	$I_{OH} = -20\mu\text{A}$	2V ~ 6V	$V_{CC} - 0.1$	$V_{CC} - 0.002$		V
			$I_{OH} = -6\text{mA}$	4.5V	4.0	4.3		
			$I_{OH} = -7.8\text{mA}$	6V	5.4	5.75		
$V_{OL}$	Low レベル出力電圧	$V_I = V_{IH}$ または $V_{IL}$	$I_{OL} = 20\mu\text{A}$	2V ~ 6V		0.002	0.1	V
			$I_{OL} = 4\text{mA}$	4.5V		0.18	0.30	
			$I_{OL} = 7.8\text{mA}$	6V		0.22	0.33	
$I_I$	入力リーク電流	$V_I = V_{CC}$ または 0		6V		$\pm 100$	$\pm 1000$	nA
$I_{CC}$	電源電流	$V_I = V_{CC}$ または 0、 $I_O = 0$		6V		0.1	2	$\mu\text{A}$
$C_i$	入力容量			2V ~ 6V			5	pF
$C_{pd}$	ゲートあたりの電力散逸容量	無負荷		2V ~ 6V		10		pF

## 5.6 スイッチング特性

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$  で測定した代表的な定格 (特に記述のない限り)。「[セクション 6](#)」を参照してください。

パラメータ		始点 (入力)	終点 (出力)	$V_{CC}$	最小値	標準値	最大値	単位
$t_{pd}$	伝搬遅延	A、B、または C	Y	2V		13	32	ns
				4.5V		6	15	
				6V		5	12	
$t_t$	遷移時間		Y	2V		9	17	ns
				4.5V		5	8	
				6V		4	7	

### 5.7 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$

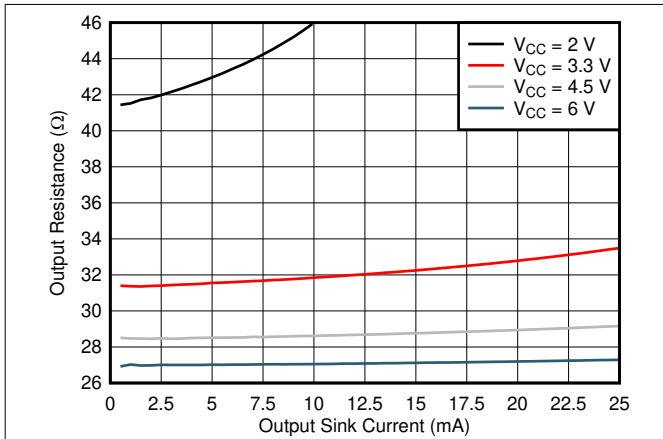


図 5-1. Low 状態の出カドライバ抵抗

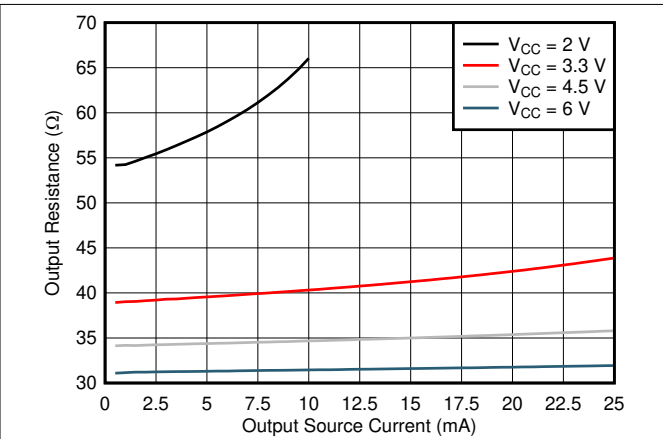


図 5-2. High 状態の出カドライバ抵抗

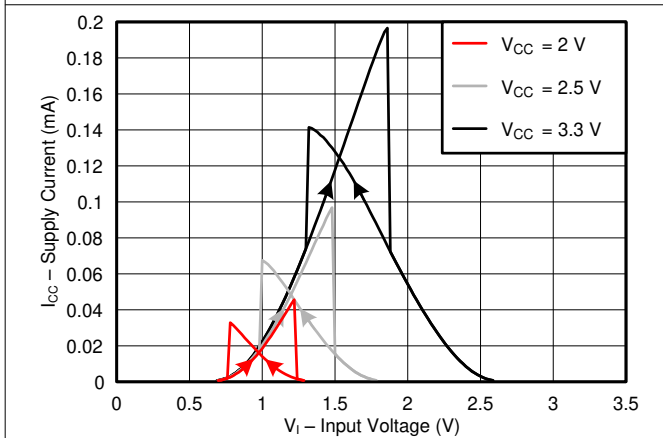


図 5-3. 標準電源電流と一般的な電源電圧値における入力電圧との関係 (2V ~ 3.3V)

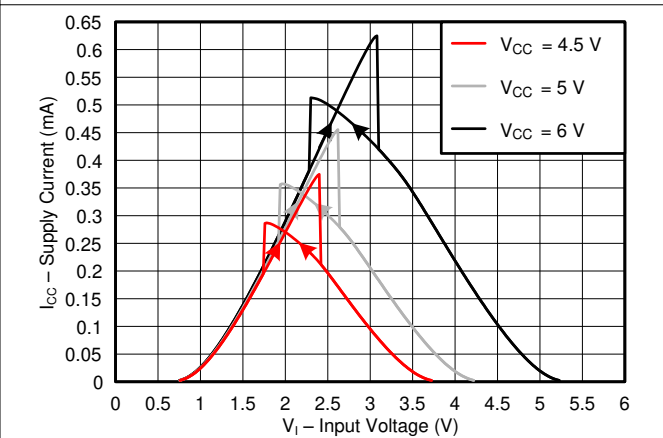
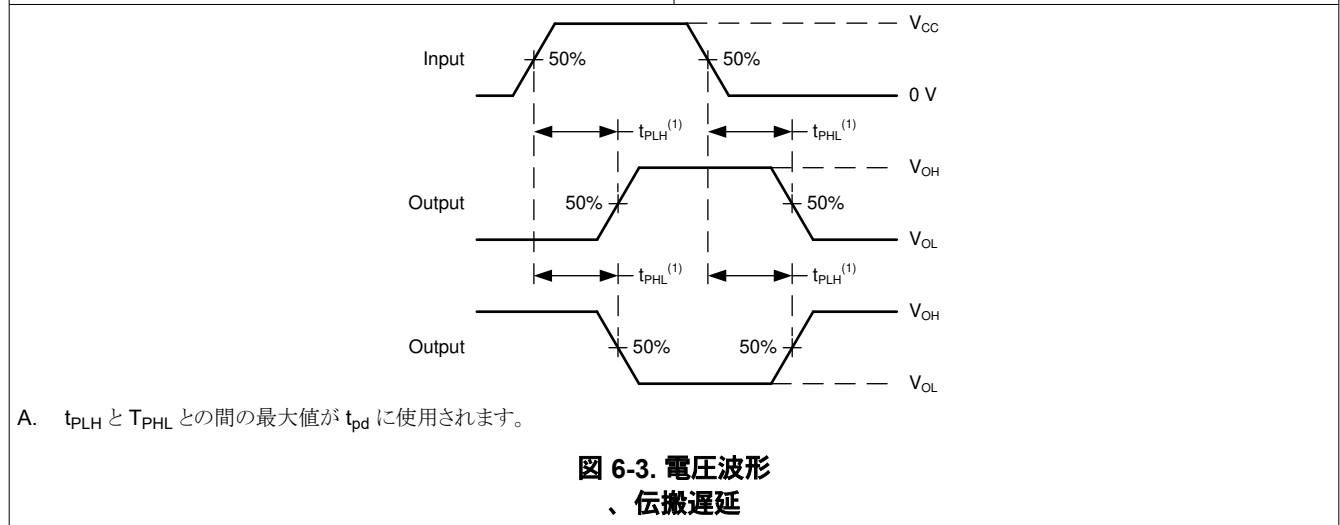
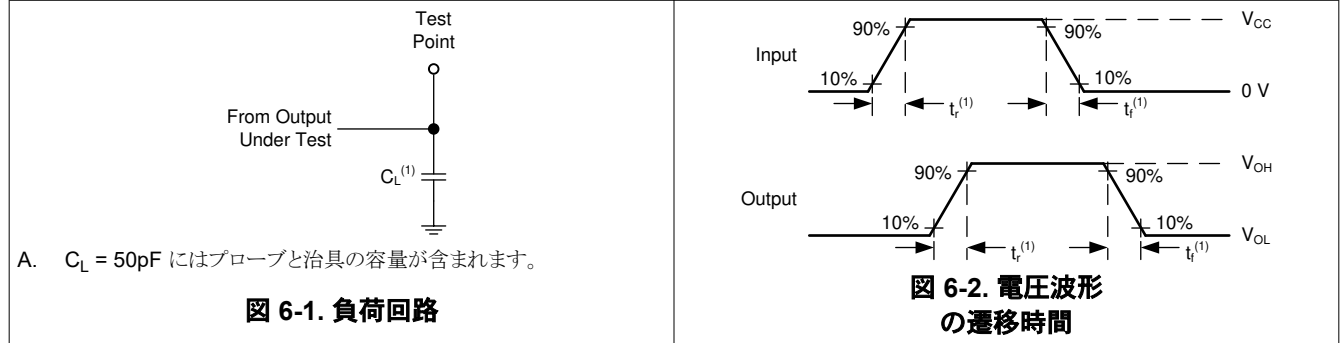


図 5-4. 標準電源電流と一般的な電源電圧値における入力電圧との関係 (4.5V ~ 6V)

## 6 パラメータ測定情報

- 波形間の位相関係は、任意に選択されます。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR  $\leq$  1MHz、 $Z_0 = 50\Omega$ 、 $t_f < 2.5\text{ns}$
- 出力は一度に1つずつ測定され、測定するたびに入力が1回遷移します。

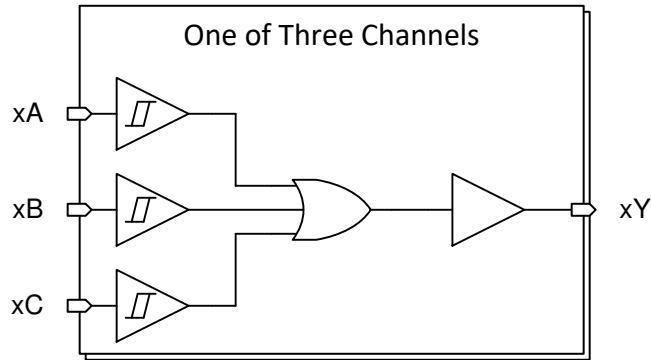


## 7 詳細説明

### 7.1 概要

このデバイスには、3つの独立した3入力 OR ゲートと、シュミットトリガ入力が入蔵されています。各ゲートはブール関数  $Y = A + B + C$  を正論理で実行します。

### 7.2 機能ブロック図



### 7.3 機能説明

#### 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力

バランスのとれた出力により、このデバイスは同程度の電流をシンクおよびソースすることができます。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「[セクション 5.1](#)」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

#### 7.3.2 CMOS シュミットトリガ入力

標準 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は「[セクション 5.5](#)」に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。最悪条件下の抵抗は、「[セクション 5.1](#)」に示されている最大入力電圧と「[セクション 5.5](#)」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ( $R = V \div I$ ) を使用して計算します。

シュミットトリガ入力アーキテクチャのヒステリシスは、[セクション 5.5](#) の  $\Delta V_T$  で定義されるため、このデバイスは低速またはノイズの多い入力に対する耐性が非常に優れています。入力は標準 CMOS 入力よりもはるかに低速で駆動できますが、未使用の入力を適切に終端することをお勧めします。入力を低速で駆動すると、デバイスの動的な電流消費も増加します。シュミットトリガ入力の詳細については、『[シュミットトリガについて](#)』を参照してください。

#### 7.3.3 クランプダイオード構造

[図 7-1](#) に示すように、このデバイスの入力と出力には正と負の両方のクランプダイオードが備わっています。

#### 注意

「[セクション 5.1](#)」表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力の負電圧と出力電圧の定格を超えることがあります。

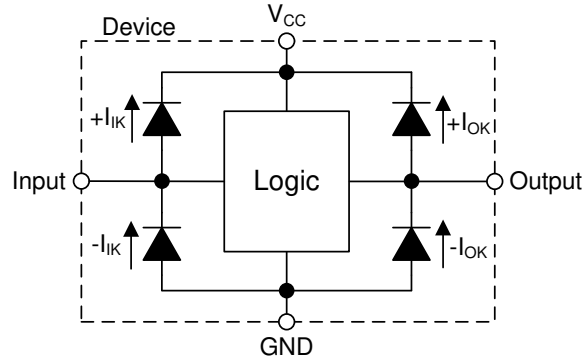


図 7-1. 各入力と出力に対するクランプ ダイオードの電氣的配置

## 7.4 デバイスの機能モード

表 7-1. 機能表

入力			出力
A	B	C	Y
L	L	L	L
H	X	X	H
X	H	X	H
X	X	H	H

## 8 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくこととなります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 8.1 使用上の注意

SN74HCS4075-Q1 には、シュミットトリガ入力採用の 3 入力 OR ゲートが内蔵されています。これら 3 入力 OR ゲートは独立して動作しますが、組み合わせることで最大 7 入力 OR ゲートとして使用することも可能です。3 つの入力すべてがアクティブな状態で使用することも、グランドに直接接続してデバイスを 2 入力 OR ゲートにすることで 1 つの入力をディスエーブルすることもできます。

SN74HCS4075-Q1 は、ファンドライバのイネーブルピンを直接制御するために使用されています。ファンドライバは、いずれか 1 つの入力信号が High になると有効化され、すべての信号が Low になると無効化される必要があります。この 3 入力 OR ゲート機能は、3 つの個別の過熱信号を 1 つのアクティブ High イネーブル信号に結合します。

温度センサは多くの場合、単一の場所に配置されるのではなく、システム全体に分散して配置されます。つまり、信号を通過させる配線の長さが長くなり、結果的にエッジ遷移が遅くなります。SN74HCS4075-Q1 は、入力遷移レートの要件がないシュミットトリガ入力を備えているため、このアプリケーションに最適です。

### 8.2 代表的なアプリケーション

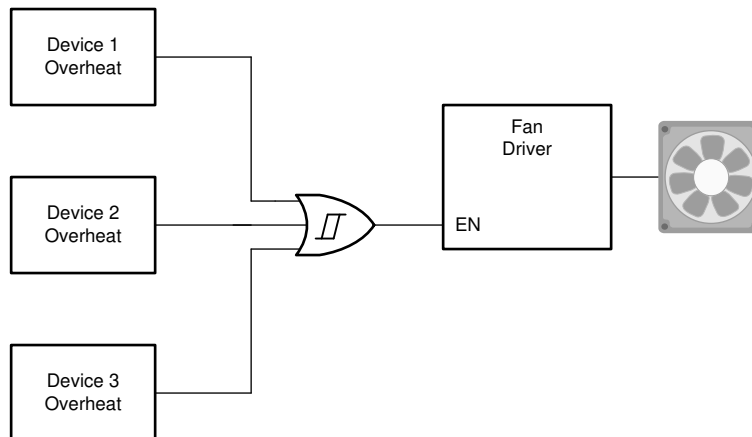


図 8-1. 代表的なアプリケーションのブロック図

#### 8.2.1 設計要件

- システムのすべての信号は 5V で動作します
- 次のいずれかの条件が当てはまる場合は、ファンドライバを有効にする必要があります。
  - デバイス 1 の過熱
  - デバイス 2 の過熱
  - デバイス 3 の過熱

##### 8.2.1.1 電源に関する考慮事項

求める電源電圧が「[セクション 5.3](#)」で規定されている範囲内であることを確認します。「[セクション 5.5](#)」に記載されているように、電源電圧はデバイスの電気的特性を設定します。

電源は、SN74HCS4075-Q1 のすべての出力によってソースされる総電流と「[セクション 5.5](#)」に記載された消費電流 ( $I_{CC}$ ) の最大値との合計に等しい電流をソースできる必要があります。ロジック デバイスは、それぞれ電源ピンとグランドピ

ンで供給される電流と同じ量の電流のみをソースまたはシンクできます。「[セクション 5.1](#)」に記載されている GND または  $V_{CC}$  を流れる最大合計電流を超えないようにしてください。

SN74HCS4075-Q1 は、データシートの仕様をすべて満たしながら、ハイインピーダンス CMOS 入力に接続された合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。これより大きな容量性負荷を印加することもできますが、70pF を超えることは推奨しません。

総消費電力は、『[CMOS の消費電力と  \$C\_{pd}\$  の計算](#)』に記載されている情報を使用して計算できます。

温度上昇は、『[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#)』に記載されている情報を使用して計算できます。

#### 注意

「[セクション 5.1](#)」に記載された最大接合部温度  $T_J(\max)$  は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。「[セクション 5.1](#)」に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

#### 8.2.1.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、ロジック Low と見なされるには  $V_t(\min)$ 、ロジック High と見なされるには  $V_{t+}(\max)$  をそれぞれ交差する (下回らないしは超える) 必要があります。「[セクション 5.1](#)」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 $V_{CC}$  またはグランドに終端させる必要があります。入力がまったく使われていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が HIGH の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が LOW の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN74HCS4075-Q1 へのリーク電流 (「[セクション 5.5](#)」で規定)、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により 10k $\Omega$  の抵抗値がしばしば使用されます。

SN74HCS4075-Q1 にはシュミットトリガ入力があるため、入力信号遷移レートの要件はありません。

シュミットトリガ入力を採用するもう 1 つの利点は、ノイズを除去できることです。振幅の大きなノイズの場合でも、問題が発生することがあります。問題が発生させる可能性があるノイズの大きさについては、「[セクション 5.5](#)」の  $\Delta V_T(\min)$  を参照してください。このヒステリシス値により、ピークツーピーク制限が得られます。

標準的な CMOS 入力の場合とは異なり、シュミットトリガ入力は、消費電力を大幅に増加させることなく、任意の有効な値に保持できます。 $V_{CC}$  でもグランドでもない値に入力を保持した場合に発生する追加の電流 (代表値) を「[セクション 5.7](#)」のグラフに示します。

このデバイスの入力に関する詳細情報については、「[セクション 7.3](#)」セクションを参照してください。

#### 8.2.1.3 出力に関する考慮事項

正の電源電圧を使用して、出力 High 電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「[セクション 5.5](#)」の  $V_{OH}$  仕様で規定されたように出力電圧が低下します。同様に、グランド電圧を使用して、出力 Low 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「[セクション 5.5](#)」の  $V_{OL}$  仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。MISSING LINK のプロットと MISSING LINK は、このデバイスの出力電圧と電流の代表的な関係を示しています。

未使用の出力はフローティングのままにできます。

このデバイスの出力に関する詳細情報については、「[セクション 7.3](#)」セクションを参照してください。

### 8.2.2 詳細な設計手順

1.  $V_{CC}$  と GND の間にデカップリングコンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ  $V_{CC}$  ピンと GND ピンの両方に電気的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「[セクション 8.3](#)」に示します。

- 出力の容量性負荷は、必ず 70pF 以下になるようにします。これは厳密な制限ではありませんが、性能が最適化されます。これは、SN74HCS4075-Q1 から受信デバイスへのパターンを短い適切なサイズにすることで実現できます。
- 出力の抵抗性負荷を ( $V_{CC}/25\text{mA}$ )  $\Omega$  より大きくします。これにより、セクション 5.1 の出力電流の最大値を上回らないようにします。ほとんどの CMOS 入力には抵抗性負荷 (測定単位は  $M\Omega$ ) があります。これは、前述の計算された最小値よりもはるかに大きな値になります。
- 熱の問題がロジック ゲートで懸念されることはほとんどありませんが、消費電力と熱の上昇はアプリケーション ノート『CMOS の消費電力と Cpd の計算』の手順を使用して計算できます。

### 8.2.3 アプリケーション曲線

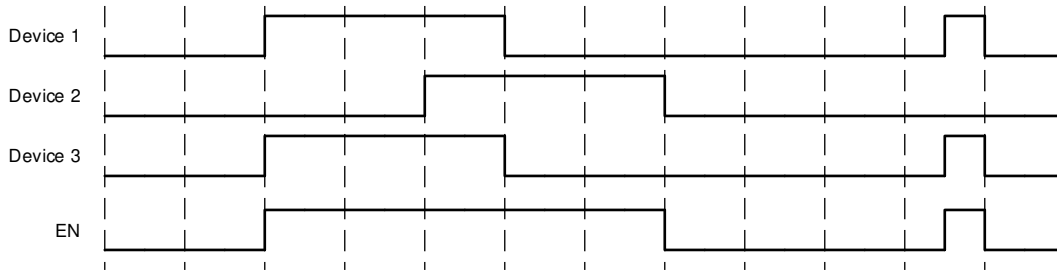


図 8-2. アプリケーションのタイミング図

### 電源に関する推奨事項

電源には、「セクション 5.3」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各  $V_{CC}$  端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。このデバイスには 0.1 $\mu\text{F}$  のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、0.1 $\mu\text{F}$  と 1 $\mu\text{F}$  のコンデンサは並列に使用されます。図 8-3 に示すように、バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

## 8.3 レイアウト

### 8.3.1 レイアウトのガイドライン

マルチ入力およびマルチチャネルのロジック デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにはなりません。多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、トリプル入力 AND ゲートの 2 つの入力のみを使用する場合や 4 つのバッファ ゲートのうちの 3 つのみを使用する場合)。このような未使用の入力ピンを未接続のままにすることはできません。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。デジタルロジック デバイスの未使用入力はすべて、入力電圧の仕様で定義されるロジック High またはロジック Low 電圧に接続して、それらがフローティングにならないようにする必要があります。特定の未使用入りに適用する必要があるロジックレベルは、デバイスの機能によって異なります。一般に入力は、GND または  $V_{CC}$  のうち、ロジックの機能にとってより適切であるかより利便性の高い方に接続されます。

### 8.3.2 レイアウト例

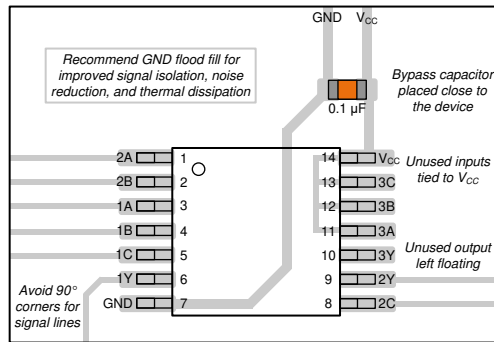


図 8-3. SN74HCS4075-Q1 のレイアウト例

## 9 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 9.1 ドキュメントのサポート

#### 9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- [HCS ロジック ファミリの採用でノイズの低減と電力の節減を実現](#)
- 『[CMOS の消費電力と CPD の計算](#)』
- 『[ロジック設計](#)』

#### 9.2 関連リンク

次の表に、クイック アクセス リンクを示します。カテゴリには、技術資料、サポートおよびコミュニティリソース、ツールとソフトウェア、およびサンプル注文またはご購入へのクイック アクセスが含まれます。

#### 9.3 サポート・リソース

[テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

#### 9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

#### 9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

#### 9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

### Changes from OCTOBER 1, 2019 to MARCH 19, 2026 (from Revision A (October 2019) to Revision B (March 2026))

	Page
• 2V の $V_{CC}$ での $V_{T+}$ の制限値を 0.7V (最小)、1.5V (最大) から 1.18V (最小)、1.3V (最大) に変更.....	5
• 4.5V の $V_{CC}$ での $V_{T+}$ の制限値を 1.7V (最小)、3.15V (最大) から 2.39V (最小)、2.58V (最大) に変更.....	5
• 6V の $V_{CC}$ での $V_{T+}$ の制限値を 2.1V (最小)、4.2V (最大) から 3.11V (最小)、3.32V (最大) に変更.....	5
• 2V の $V_{CC}$ での $V_{T-}$ の制限値を 0.3V (最小)、1.0V (最大) から 0.61V (最小)、0.66V (最大) に変更.....	5
• 4.5V の $V_{CC}$ での $V_{T-}$ の制限値を 0.9V (最小)、2.2V (最大) から 1.31V (最小)、1.42V (最大) に変更.....	5
• 6V の $V_{CC}$ での $V_{T-}$ の制限値を 1.2V (最小)、3.0V (最大) から 1.72V (最小)、1.87V (最大) に変更.....	5
• 2V の $V_{CC}$ での $\Delta V_T$ の制限値を 0.2V (最小)、1.0V (最大) から 0.55V (最小)、0.67V (最大) に変更.....	5
• 4.5V の $V_{CC}$ での $\Delta V_T$ の制限値を 0.4V (最小)、1.4V (最大) から 1.04V (最小)、1.21V (最大) に変更.....	5
• 6V の $V_{CC}$ での $\Delta V_T$ の制限値を 0.6V (最小)、1.6V (最大) から 1.34V (最小)、1.49V (最大) に変更.....	5

Changes from Revision * (August 2019) to Revision A (October 2019)	Page
• データシートに D パッケージを追加.....	1
• 動作周囲温度範囲 (特に記述のない限り) において、明確化のため、「V <sub>CC</sub> または GND を流れる連続電流」から「I <sub>CC</sub> 」および「出力」を.....	4

## 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">SN74HCS4075QDRQ1</a>	Active	Production	SOIC (D)   14	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCS4075Q
SN74HCS4075QDRQ1.A	Active	Production	SOIC (D)   14	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCS4075Q
<a href="#">SN74HCS4075QPWRQ1</a>	Active	Production	TSSOP (PW)   14	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HC4075Q
SN74HCS4075QPWRQ1.A	Active	Production	TSSOP (PW)   14	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HC4075Q
SN74HCS4075QPWRQ1.B	Active	Production	TSSOP (PW)   14	2000   LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74HCS4075-Q1 :**

- Catalog : [SN74HCS4075](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74HCS4075QDRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**



\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74HCS4075QDRQ1	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0

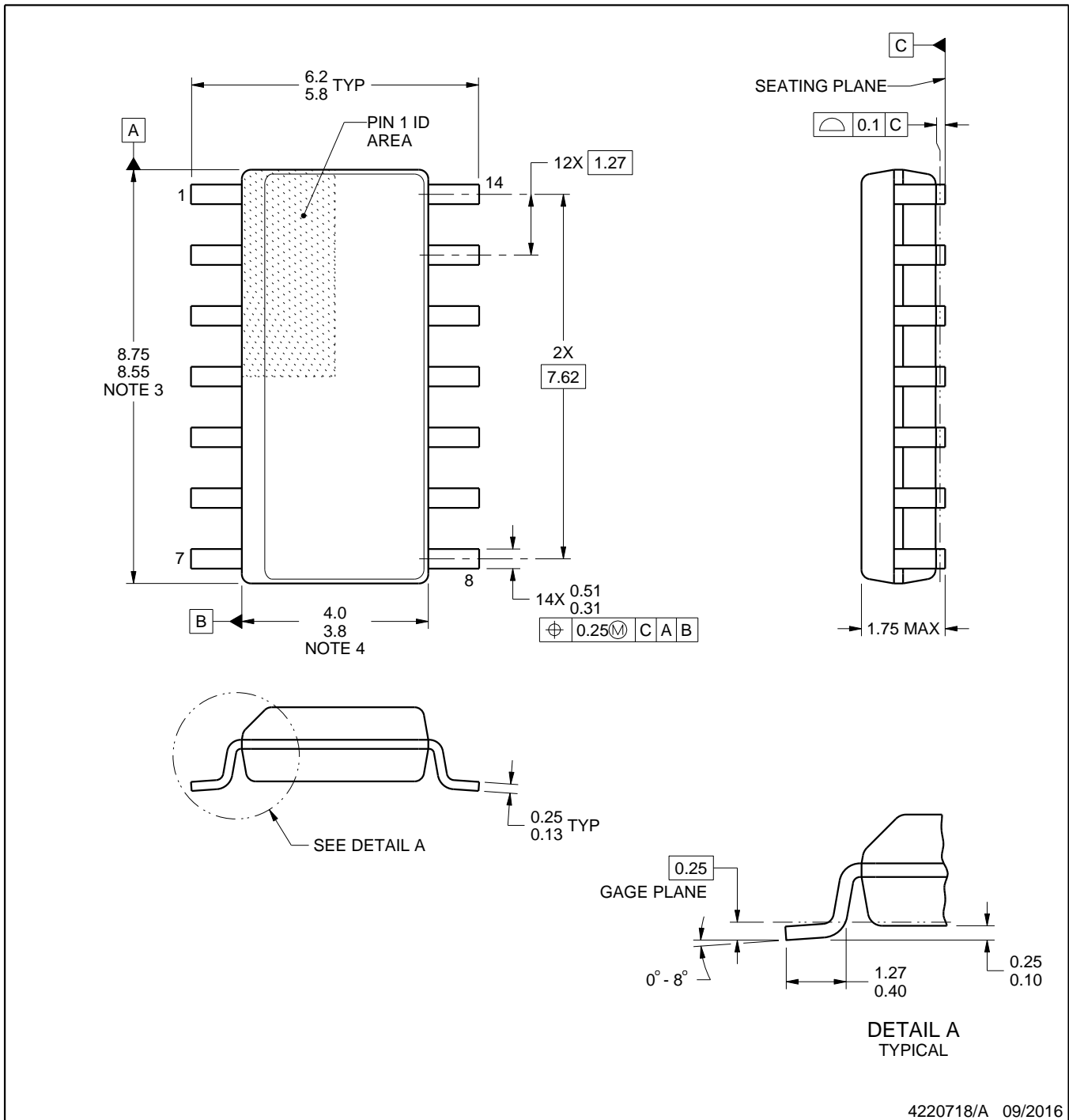
D0014A



# PACKAGE OUTLINE

## SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.







4220202/B 12/2023

NOTES:

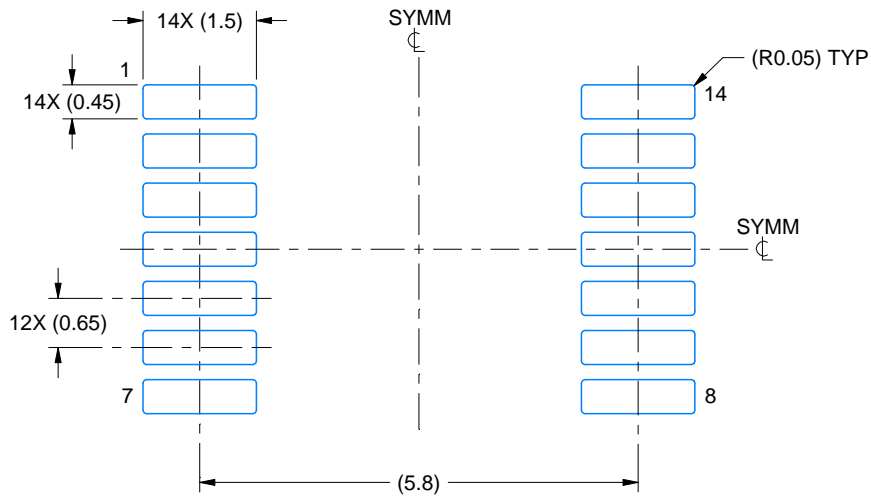
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

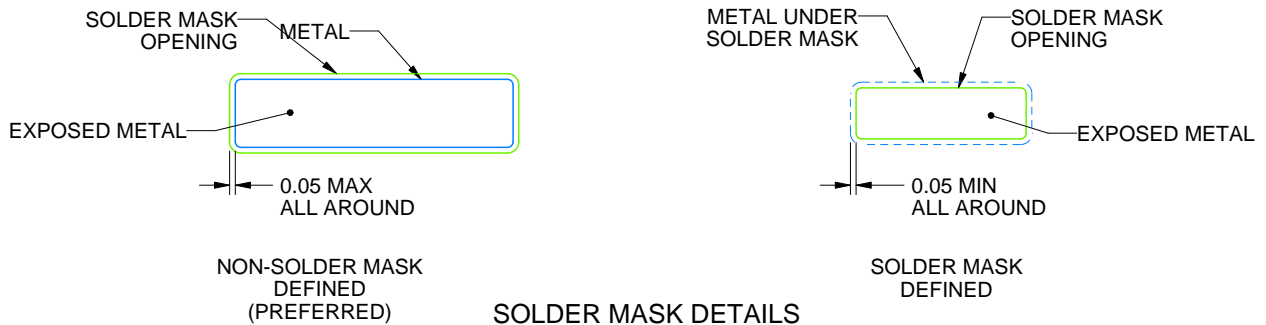
PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月